



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 6351—1998  
idt IEC 747-2-1:1989  
QC 750108

---

## 半导体器件 分立器件 第2部分:整流二极管 第一篇 100A以下环境或管壳额定 整流二极管(包括雪崩整流二极管) 空白详细规范

Semiconductor devices—Discrete devices  
Part 2: Rectifier diodes  
Section One—Blank detail specification for  
rectifier diodes (including avalanche recti-  
fier diodes), ambient and case-rated, up to 100A

1998-11-17 发布

1999-06-01 实施

国家质量技术监督局 发布

## 前 言

本规范等同采用 IEC 747-2-1:1989《半导体器件 分立器件 100A 以下环境或管壳额定整流二极管(包括雪崩整流二极管)空白详细规范》。本规范是 GB/T 6351—1987 的修订版。

本规范与 GB/T 6351—1986 的主要差别是:在第 5 章中增加了 5.5 总耗散功率。原来的 5.5 热阻改为 5.6,删去了 C2d 分组热阻。

除非另有规定,在本规范第 8 章中引用的条号对应于 GB/T 4589.1—1989《半导体器件 分立器件和集成电路总规范》(IEC 747-10:1984)的条号,测试方法引自 GB/T 4023—1997。

《半导体器件 分立器件 第 2 部分:整流二极管》(IEC 747-2:83);试验方法引自 GB/T 4937—1995《半导体器件机械和气候试验方法》(IEC 749:1984)。

本规范由中华人民共和国电子工业部提出。

本规范由全国半导体器件标准化技术委员会归口。

本规范由电子工业部标准化研究所负责起草。

本规范主要起草人:于志贤、刘东才、王保桢。

## IEC 前言

1) IEC(国际电工委员会)在技术问题上的正式决议或协议,是由对这些问题特别关切的国家委员会参加的技术委员会制定的,对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见。

2) 这些决议或协议,以推荐标准的形式供国际上使用,并在此意义上为各国家委员会所认可。

3) 为了促进国际间的统一,IEC 希望各国家委员会在本国条件许可的情况下,采用 IEC 标准的文本作为其国家标准,IEC 标准与相应国家标准之间的差异,应尽可能在国家标准中指明。

本标准由 IEC 第 47 技术委员会(半导体器件)制定。

本标准是 100A 以下环境或管壳额定整流二极管(包括雪崩整流二极管)空白详细规范。

本标准文本以下列文件为依据:

六个月法	表决报告
47(CO)959	47(CO)1009

表决批准本标准的所有资料均可在上表所列的表决报告中查阅。

本标准封面上出现的 QC 号是 IEC 电子元器件质量评定体系(IECQ)的规范号。

本标准中引用的其他 IEC 标准:

IEC 68-2-17:1978 基本环境试验程序 第 2 部分:试验,试验 Q:密封

IEC 191-2:1966 半导体器件的机械标准化 第 2 部分:尺寸(在修订中)

IEC 747-2:1983 半导体器件 分立器件 第 2 部分:整流二极管

IEC 747-10:1984 半导体器件 第 10 部分:分立器件和集成电路总规范

IEC 747-11:1985 半导体器件 第 11 部分:分立器件分规范

IEC 749:1984 半导体器件 机械和气候试验方法

# 中华人民共和国国家标准

## 半导体器件 分立器件

### 第2部分:整流二极管

#### 第一篇 100A以下环境或管壳额定

#### 整流二极管(包括雪崩整流二极管)

#### 空白详细规范

Semiconductor devices—Discrete devices

Part 2: Rectifier diodes

Section One—Blank detail specification for

rectifier diodes(including avalanche rectifier diodes), ambient and case-rated, up to 100A

GB/T 6351—1998  
idt IEC 747-2-1:1989  
QC 750108

代替 GB/T 6351—1986

#### 引言

本空白详细规范规定了制定环境或管壳额定整流二极管(包括雪崩整流二极管)详细规范的基本原则,制定该范围内的所有详细规范应尽可能与本空白详细规范相一致。

本标准是与 GB/T 4589.1—1989《半导体器件 分立器件和集成电路总规范》(IEC 747-10:1984)和 GB/T 12560—1990《半导体器件 分立器件分规范》(IEC 747-11:1985)有关的一系列空白详细规范中的一个。

#### 要求资料

下列所要求的各项内容,应列入规定的相应空栏中。

详细规范的识别:

- [1] 授权起草详细规范的国家标准机构的名称。
- [2] IECQ 详细规范号。
- [3] 总规范号和分规范号以及年代号。
- [4] 详细规范号、发布日期和国家体系要求的更多的资料。

器件的识别:

- [5] 器件型号。

[6] 典型结构和应用资料。如果设计一种器件满足若干应用,则应在详细规范中指出。这些应用的特性、极限值和检验要求均应予以满足。如果器件对静电敏感或含有害物质,例如氧化铍,则应在详细规范中附加注意事项。

- [7] 外形图和(或)引用有关的外形标准。

- [8] 质量评定类别。

- [9] 能在各器件型号之间比较的最重要特性的参考数据。

[在方括号内给出的内容供指导规范制订者使用,而不包括在详细规范内。]

[整个空白详细规范中,当特性或额定值适用时,×表示在详细规范中应填入的值。]